

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載
 【部門区分】第6部門第4区分
 【発行日】平成26年10月9日(2014.10.9)

【公開番号】特開2012-256402(P2012-256402A)
 【公開日】平成24年12月27日(2012.12.27)
 【年通号数】公開・登録公報2012-055
 【出願番号】特願2011-245230(P2011-245230)
 【国際特許分類】

G 1 1 C 11/404 (2006.01)
 H 0 1 L 29/786 (2006.01)
 H 0 1 L 27/108 (2006.01)
 H 0 1 L 21/8242 (2006.01)
 H 0 1 L 21/336 (2006.01)
 H 0 1 L 29/788 (2006.01)
 H 0 1 L 29/792 (2006.01)
 H 0 1 L 27/115 (2006.01)
 H 0 1 L 21/8247 (2006.01)
 H 0 1 L 27/10 (2006.01)

【F I】

G 1 1 C 11/34 3 5 2 C
 H 0 1 L 29/78 6 1 3 B
 H 0 1 L 29/78 6 1 8 B
 H 0 1 L 29/78 6 1 8 G
 H 0 1 L 27/10 6 1 5
 H 0 1 L 27/10 6 7 1 C
 H 0 1 L 27/10 6 7 1 Z
 H 0 1 L 29/78 3 7 1
 H 0 1 L 27/10 4 3 4
 H 0 1 L 27/10 4 8 1
 H 0 1 L 27/10 4 6 1

【手続補正書】

【提出日】平成26年8月22日(2014.8.22)

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】発明の名称

【補正方法】変更

【補正の内容】

【発明の名称】半導体装置

【手続補正2】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

第1の配線と、
第2の配線と、
第3の配線と、

第 1 のトランジスタと、
第 2 のトランジスタと、
容量素子と、を有し、
前記第 1 のトランジスタのゲートは、前記第 1 の配線と電氣的に接続され、
前記第 1 のトランジスタのソース又はドレインの一方は、前記第 2 の配線と電氣的に接
続され、
前記第 1 のトランジスタのソース又はドレインの他方は、前記容量素子の第 1 の電極と
電氣的に接続され、
前記容量素子の第 2 の電極は、前記第 3 の配線と電氣的に接続され、
前記第 3 の配線は、前記第 2 のトランジスタのゲートと電氣的に接続され、
前記第 1 のトランジスタは、第 1 の酸化物半導体を有し、
前記第 2 のトランジスタは、第 2 の酸化物半導体を有する
ことを特徴とする半導体装置。

【請求項 2】

請求項 1 において、
第 1 のメモリセルと、
前記第 1 のメモリセル上の、第 2 のメモリセルと、を有し、
前記第 1 のメモリセルは、前記第 2 のトランジスタを有し、
前記第 2 のメモリセルは、前記第 1 のトランジスタを有することを特徴とする半導体装
置。

【請求項 3】

請求項 1 又は請求項 2 において、
前記第 1 の酸化物半導体及び前記第 2 の酸化物半導体は、表面に垂直な方向に c 軸が配
向した結晶領域を有することを特徴とする半導体装置。